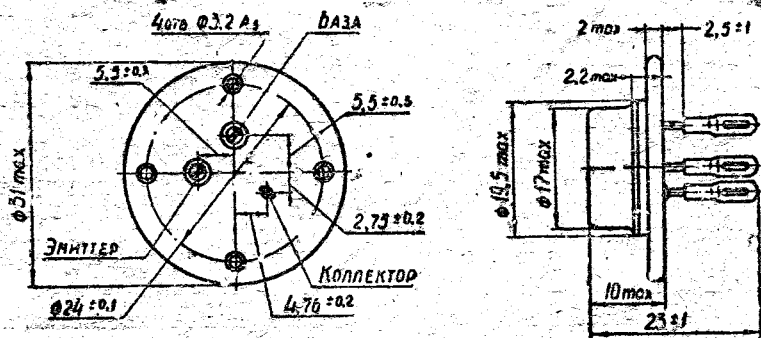




# ГЕРМАНИЕВЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ МОЩНЫЕ ТРИОДЫ ТИПОВ П4АЭ, П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П4ДЭ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СИЗ.365.005 ТУ



## Общие данные

Тип: германиевый р-р-р плоскостной мощный триод.

Номинальная выходная мощность — 10 вт.

Конструкция триода герметична и обеспечивает:

- а) сохранность параметров при длительном воздействии вибрации с ускорением до 12 g;
- б) устойчивость к воздействию постоянных ускорений до 150 g и ударных до 150 g;
- в) отсутствие резонансных частот и виброустойчивость в диапазоне 10—600 гц.

## Электрические данные

Наименование параметров	Обознач.	Ед. изм.	Типы транзисторов				
			П4АЭ	П4БЭ	П4ВЭ	П4ГЭ	П4ДЭ
1. Усиление по току при $I_k = 2$ а, $U_k = -10$ в $f = 1$ кГц	$\beta$	мин. макс.	5	15	10	15	30
2. Нулевой ток коллектора при $U_k = -10$ в	$I_{к0}$	мкА макс.	500	400	400	400	400
3. Усиление по мощности при $U_k = -26$ в, $I_k = 1$ а, $R_T = 15$ ом, $R_n = 25$ ом	$K_M$	дБ мин.	20	23	—	27	30
4. Тепловое сопротивление	$R_T$	°C/вт макс.	2	2	2	2	2

Продолжение

Наименование параметров	Обознач.	Ед. изм.	Типы транзисторов				
			П4АЭ	П4БЭ	П4ВЭ	П4ГЭ	П4ДЭ
5. Предельная частота усиления (для схемы с общей базой)	$f_{0a}$	кГц	макс. 150	150	150	150	150
6. Мощность, рассеиваемая коллектором (при температуре корпуса +40°C)	$P_{рас}$	вт	макс. 20	25	25	25	25
7. Напряжение между коллектором и эмиттером при $I_k=2$ а, $I_b=0,3$ а	$U_{эк}$	в	макс. —	0,5	0,5	0,5	0,5

**Предельно допустимые эксплуатационные данные**

№ ин.	Тип прибора	Максимальн. коллекторн. напряжен.			Максимальный ток коллектора, а	Максимальный ток базы, а
		для схем с общей базой, в	для схем с общим эмиттер., в	для схем с общим коллектором, в		
1	П4АЭ	60	50	40	5	1,2
2	П4БЭ	70	60	50	5	1,2
3	П4ВЭ	40	35	25	5	1,2
4	П4ГЭ	60	50	40	5	1,2
5	П4ДЭ	60	50	40	5	1,2

**Указания по эксплуатации**

1. Для работы триод необходимо прочно привинтить к теплоотводящей панели, обеспечив надежный тепловой контакт.

2. Допустимая мощность рассеивания определяется температурой корпуса прибора.

3. В процессе работы не разрешается превосходить предельно допустимые значения параметров.

4. Пайка к выводам транзистора допускается на плоской части вывода.

5. Допустимая мощность, рассеиваемая на коллекторе при температуре свыше +40°C на корпусе, определяется по формуле:

$$P_{рас} = \frac{90^\circ - t_{корп}^\circ}{2^\circ\text{C}/\text{вт}}$$

где  $P_{рас}$  — предельно допустимая мощность рассеивания при температуре корпуса  $t^\circ\text{C}$ .

6. Предельная температура корпуса +70°C.

Дата выпуска 1 4 8 10 5 контролер ОТК

